(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年1 月24 日 (24.01.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/06263 A1

(51) 国際特許分類?: C07D 307/79, C07C

67/29, 69/16, 67/293, 69/18, C07F 3/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP01/06296

(22) 国際出願日: 2001年7月19日(19.07.2001)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特闘2000-219902 2000年7月19日(19,07,2000) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 中 外製薬株式会社 (CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒115-8543 東京都北区浮間5丁目 5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 免明者/出願人(米国についてのみ): 田村邦雄(TMMURA, Kunio) [JP/JP]. 清水裕仁 (SHIMIZU, Hirohito) [JP/JP]. 〒115-8343 東京都北区浮間5丁目 5番 号 中外製業株式会社内 Tokyo (JP). 加藤好電(KATO, Veshiaki) [JP/JP]: 〒412-8313 前間県御殿場市 駒門1丁目135番地中外製業株式会社内 Shizuoka (SHIMIZU, Masshiro) [JP/JP]: 〒115-8343 東京都北区浮間5丁目5番1号 中外製業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 社本一夫、外(SHAMOTO, Ichio et al.); 〒 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手 町ビル206区 ユアサハラ法律特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

[糖葉有]

(54) Title: PROCESS FOR THE PREPARATION OF A BENZOFURAN DERIVATIVE

(54) 発明の名称: ペンゾフラン誘導体の製造方法

(57) Abstract: An industrially advantageous process for the preparation of the benzofuran derivative of formula (1) characterized by formylating a compound of the general formula (2) (wherein A₁ is a protective group), reacting the obtained formyl compound with a compound of the general formula (4) (wherein X₁ is halogeno), and then subjecting the obtained compound to ring closure and deblocking into hydroxyl group successively.

(4)

WO 02/06263 A1

[統葉有]

LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

一般式 (2)

(式中、A,は、保護基を示す。)

で表される化合物をホルミル化した後、一般式(4)

(式中、X,は、ハロゲン原子を示す。)

で表される化合物を反応させ、次に閉環反応を行い、続いて水酸基の脱保護反応 を行うことを特徴とする、一般式(1)

で表されるベンゾフラン誘導体の工業的に有用な製造方法。

明 細 書 ペンゾフラン誘導体の製造方法

技術分野

5 本発明はベンゾフラン誘導体の工業的に有用な製造方法に関する。

背景技術

下記式(1)で表される化合物は、動脈硬化症や心筋梗塞等の虚血性疾患の治療剤として有用な抗酸化剤として公知の物質であり、その製造方法は特開平6-206842号公報、WO94/08930公報、US5,574,178公報に記載されている。

しかしながら、かかる製造方法においては反応工程が長く、反応の途中で複数 回のカラムクロマトグラフィーによる精製工程を含む等、必ずしも工業的製造方 法として満足できるものではなかった。

15

10

発明の開示

本発明者らは鋭意研究を重ねた結果、式(1)

20 で表される化合物の効率的な製造方法を見いだし、本発明を完成させた。

すなわち、本発明は、工業的に有用なペンゾフラン誘導体を製造する方法に関する。

具体的には、本発明は、式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、式(2)

(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物をホルミル化して式(3)

10

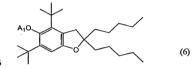
(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物を得る第1のステップと、式 (3) で表される化合物を水素化 金属と反応させた後、式 (4)

(式中、X,はハロゲン原子を示す)で表される化合物と反応させて式(5)

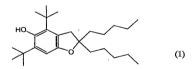
(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を得る第3のステップと、式 (5) で表される化合物を閉環して式 (6)



(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を得る第5のステップと、式 (6) で表される化合物を脱保護して、式 (1)



10 で表される化合物を得る第7のステップとを行うことを特徴とする製造方法を提供するものである。

また、本発明は、式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、式(2)

(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物をホルミル化して式(3)

(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物を得る第1のステップと、式(3)で表される化合物を低級アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式(3)で表 10 される化合物を得る第2のステップと、式(3)で表される化合物を水素化金属と反応させた後、式(4)

(式中、 X_1 はハロゲン原子を示す) で表される化合物と反応させて式(5)

(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物を得る第3のステップと、式(5)で表される化合物を、炭化水素中または低級アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式(5)で表される化合物を得る第4のステップと、式(5)で表される化合物を閉瓔して式(6)

(式中、A, は保護基を示す)

10

で表される化合物を得る第5のステップと、式(6)で表される化合物を低級アルコール中アルカリで処理した後、酸化アルミニウムで処理することにより、精製された式(6)で表される化合物を得る第6のステップと、式(6)で表される化合物を脱保護して、式(1)

で表される化合物を得る第7のステップとを行うことを特徴とする製造方法を提 15 供するものである。

加えて、本発明は、

式(12)

10

20

$$X_2$$
 (12)

(式中、X,はハロゲン原子を示す)

で表される化合物を、ジエチルエーテルあるいはテトラヒドロフラン中、マグネシウムで処理することにより式(13)

$$MgX_2$$
 (13)

(式中、X,はハロゲン原子を示す)

で表される化合物を得、得られた化合物を蟻酸エステルで処理することにより式 (14)

で表される化合物を得る第15のステップと、得られた化合物を塩化メタンスルホニルあるいは塩化p-トルエンスルホニルで処理することにより式(15)

(式中、R,はメタンスルホニル基またはp - トルエンスルホニル基を示す。) で表される化合物を得、得られた化合物をハロゲン化剤で処理することによりハロゲン化して式(16)

(式中、X₁はハロゲン原子を示す)

で表される化合物を得、得られた化合物をマグネシウムで処理することにより式 (4)

(式中、X,はハロゲン原子を示す。)

で表される化合物を製造する方法を提供するものである。

また、本発明は、式(2)

5 (式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を酸触媒存在下へキサメチレンテトラミンで処理した後、加水 分解することにより式(3)

(式中、A, は保護基を示す)

10 で表される化合物を製造する方法を提供するものである。

さらに、本発明は、式(9)

(式中、A, A, は保護基を示す)

で表される化合物を酸触媒存在下へキサメチレンテトラミンで処理した後、加水 15 分解することにより式 (3)

(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物を製造する方法を提供するものである。

加えて、本発明は、式(3)

5

(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を水素化金属と反応させた後、式(4)

(式中、X,はハロゲン原子を示す)

10 で表される化合物と反応させて式(5)

(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物を得、得られた式(5)で表される化合物を、炭化水素中また は低級アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式

(5)で表される化合物を製造する方法を提供するものである。 さらに加えて、本発明は、式(5)

(式中、A,は保護基を示す)

5 で表される化合物を閉環して式(6)

(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を得、得られた式(6)で表される化合物を低級アルコール中 アルカリで処理した後、酸化アルミニウムで処理することにより、精製された式 (6)で表される化合物を製造する方法を提供するものである。

また、本発明は、式(1)

10

で表される化合物を製造する方法であって、式(9)

(式中、A, A, は保護基を示す)

で表される化合物を酸触媒存在下ヘキサメチレンテトラミンで処理した後、加水 分解して式(3)

(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を得る第14のステップと、式(3)で表される化合物を水素 化金属と反応させた後、式(4)

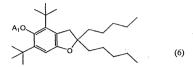
10 (式中、X,はハロゲン原子を示す)

で表される化合物と反応させて式(5)

(式中、A₁は保護基を示す)

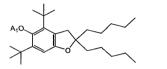
で表される化合物を得る第3のステップと、式(5)で表される化合物を閉環し

て式 (6)



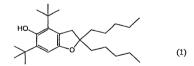
(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を得る第5のステップと、式(6)



(式中、A」は保護基を示す)

で表される化合物を脱保護して、式(1)



で表される化合物を得る第7のステップとを行うことを特徴とする製造方法を提 10 供するものである。

(6)

加えて、本発明は、式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、式(9)

(式中、A, A, は保護基を示す)

で表される化合物を酸触媒存在下へキサメチレンテトラミンで処理した後、加水 分解して式(3)

(式中、A, は保護基を示す)

10

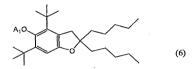
で表される化合物を得る第14のステップと、式(3)で表される化合物を低級 アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式(3)で 表される化合物を得る第2のステップと、式(3)で表される化合物を水素化金 属と反応させた後、式(4)

(式中、X₁はハロゲン原子を示す)

で表される化合物と反応させて式(5)

(式中、A,は保護基を示す)

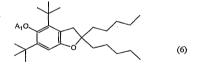
で表される化合物を得る第3のステップと、式(5)で表される化合物を、炭化水素中または低級アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式(5)で表される化合物を得る第4のステップと、式(5)で表される化合物を閉環して式(6)



(式中、A,は保護基を示す)

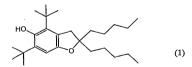
. 10

で表される化合物を得る第5のステップと、式(6)で表される化合物を低級アルコール中アルカリで処理した後、酸化アルミニウムで処理することにより、精製された式(6)で表される化合物を得る第6のステップと、式(6)



(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を脱保護して、式(1)



15 で表される化合物を得る第7のステップとを行うことを特徴とする製造方法を提供するものである。

発明を実施するための最良の形態

本発明における以下の用語には、特に示さない限り、以下に示す意味が含まれる。

本発明において、低級とは炭素数1から4のものをいい、例えば低級アルコールとは炭素数1から4の脂肪族アルコール、低級アシル基とは炭素数1から4のアシル基を意味する。また、物質に対する倍量とは、物質1重量に対する重量比をいう。たとえば、物質に対して2倍量とは、物質1重量に対して2重量であることを意味する。

低級アシル基としては、例えば、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、 10 ブチリル基、イソブチリル基などがあげられる。

A₁、A₂における保護基としては、例えば、低級アシル基などがあげられ、低級アシル基が好ましく、さらにアセチル基が好ましい。

ハロゲン化剤としては、例えば、塩化カリウム、塩化リチウム、臭化リチウム、 ヨウ化リチウムがあげられ、塩化カリウム、塩化リチウムが好ましく、さらに塩 化リチウムが好ましい。

X₁におけるハロゲン原子としては、例えば、塩素、臭素、ヨウ素があげられ、 塩素、臭素が好ましく、さらに塩素が好ましい。

X₁におけるハロゲン原子としては、例えば、塩素、臭素、ヨウ素があげられ、 塩素、臭素が好ましく、さらに臭素が好ましい。

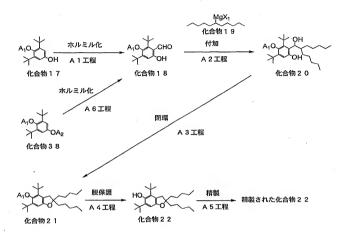
20 次に、本発明の製造方法について説明する。

15

本発明の製造方法の例を以下に示す(A法~D法)。

A法

5



(式中、A、A,は保護基を示し、X,はハロゲン原子を示す。)

A法は、前記式(2)で表される化合物としての化合物17を原料として、前 記式(1)で表される化合物としての化合物22を製造する方法または前記式 (1) で表される化合物としての精製された化合物22を製造する方法である。 まず、前記式(2)で表される化合物としての化合物17をホルミル化して前記 式(3)で表される化合物としての化合物18を得る(A1工程)。ホルミル化 反応は、酸触媒存在下ヘキサメチレンテトラミンで処理した後、加水分解前記す 10 ることにより行うことができる。

酸触媒としては、例えばトリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸があげられ、メ タンスルホン酸が好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例 えば酢酸、トリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸、メタンスルホン酸と酢酸との

混合溶媒、n-ヘブタン、シクロヘキサンなどがあげられ、酢酸、トリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸、メタンスルホン酸と酢酸との混合溶媒が好ましく、さらにトリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸、メタンスルホン酸と酢酸との混合溶媒が好ましい。ここで用いられるヘキサメチレンテトラミンは、化合物17に対して通常1当量から5当量であり、1.5当量から2.5当量が好ましく、さらに2当量から2.5当量が好ましい。反応温度は、通常70℃から100℃であり、80℃から100℃が好ましい。反応時間は、通常1時間から6時間であり、1時間から2時間が好ましい。反応時間は、通常80℃から105℃であり、90℃から105℃が好ましく、さらに95℃から105℃が好ましく、さらに95℃から105℃が好ましく、さらに95℃から105℃が好ましく、さらに5時間から8時間が好ましい。加水分解時間は、通常1時間から10時間であり、3時間から8時間が好ましく、さらに5時間から7時間が好ましい。得られた化合物18は所望により精製するが、精製するのが好ましい。精製法としては再結晶が好ましい。

10

15

20

25

再結晶に用いる溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロパノールなどの低級アルコールと水との混合溶媒が好ましく、さらにイソプロパノールと水との混合溶媒が好ましい。ここで、イソプロパノールと水との混合比は、1:1から2:1が好ましく、さらに3:1.8から3:2.2が好ましい。再結晶に用いられる溶媒量は、化合物2に対して4倍量から8倍量が好ましく、さらに4倍量から6倍量が好ましい。再結晶温度は、通常0℃から30℃であり、0℃から20℃が好ましい。再結晶時間は、通常15分から10時間であり、0.5時間から3時間が好ましい。

ここで、前記式(3)で表される化合物としての化合物18は、前記式(9)で表される化合物としての化合物38を酸触媒存在下ヘキサメチレンテトラミンで処理した後、加水分解することによって得ることもでき(A6工程)、作業量の低減の点で好ましい。

酸触媒としては、例えばトリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸があげられ、メタンスルホン酸が好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えば酢酸、トリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸、メタンスルホン酸と酢酸との混合溶媒、n-ヘブタン、シクロヘキサンなどがあげられ、酢酸、トリフルオロ

酢酸、メタンスルホン酸、メタンスルホン酸と酢酸との混合溶媒が好ましく、さ らにトリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸、メタンスルホン酸と酢酸との混合溶 媒が好ましく、特にメタンスルホン酸が好ましい。ここで用いられるヘキサメチ レンテトラミンは、化合物38に対して通常1当量から5当量であり、1.5当 畳から2.5当量が好ましく、さらに2当量から2.5当量が好ましい。反応温 度は、通常70℃から100℃であり、80℃から100℃が好ましく、さらに 80℃から90℃が好ましい。反応時間は、通常1時間から6時間であり、3時 間から4時間が好ましい。加水分解温度は、通常80℃から105℃であり、9 0℃から 1 0 5℃が好ましく、さらに 9 5℃から 1 0 5℃が好ましい。加水分解 時間は、通常1時間から10時間であり、3時間から8時間が好ましく、さらに 5時間から7時間が好ましい。得られた化合物18は所望により精製するが、精 製するのが好ましい。精製法としては再結晶が好ましい。再結晶に用いる溶媒と しては、メタノール、エタノール、イソプロパノールなどの低級アルコールと水 との混合溶媒が好ましく、さらにイソプロパノールと水との混合溶媒が好ましい。 ここで、イソプロパノールと水との混合比は、1:1から2:1が好ましく、さ らに3:1.8から3:2.2が好ましい。再結晶に用いられる溶媒量は、化合 物2に対して4倍量から8倍量が好ましく、さらに4倍量から6倍量が好ましい。 再結晶温度は、通常0 \mathbb{C} から30 \mathbb{C} であり、0 \mathbb{C} から20 \mathbb{C} が好ましい。再結晶 時間は、通常15分から10時間であり、0.5時間から3時間が好ましい。

10

15

20

25

次に、前記式(3)で表される化合物としての化合物18に、水素化金属の存在下、前記式(4)で表される化合物としての化合物19を反応させて前記式(5)で表される化合物としての化合物20を得る(A2工程)。水素化金属としては、例えば水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化カルシウムなどがあげられ、水素化リチウム、水素化ナトリウムが好ましく、さらに水素化ナトリウムが好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えばテトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジメトキシエタン、トルエンなどがあげられ、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルが好ましく、さらにテトラヒドロフランが好ましい。ここで用いられる化合物19は、化合物18に対して通常1当量から3当量であり、1当量から2当量が好ましく、さらに1.2当

量から2当量が好ましい。反応温度は、通常0℃から35℃であり、0℃から30℃が好ましく、さらに5℃から25℃が好ましい。反応時間は、通常1時間から5時間であり、1時間から3時間が好ましく、さらに2時間から3時間が好ましい。上記の操作により化合物20を得ることができる。ここで、得られた化合物20は所望により精製するが、精製するのが好ましい。精製法としては再結晶が好ましい。再結晶に用いる溶媒としては、n-ヘキサン、n-ヘブタンなどの炭化水素、または、メタノール、エタノール、イソプロパノールなどの低級アルコールと水との混合溶媒が好ましく、さらにn-ヘキサン、n-ヘブタンが好ましく、特にn-ヘブタンが好ましい。再結晶に用いられる溶媒量は、化合物20に対して8倍量から15倍量が好ましい。再結晶に用いられる溶媒量は、化合物20に対して8倍量から15倍量が好ましい。再結晶温度は、通常0℃から30℃であり、0℃から15℃が好ましい。再結晶時間は、通常1時間から10時間であり、1時間から3時間が好ましい。

次に、前記式(5)で表される化合物としての化合物20を酸で処理することにより閉環し、次にアルカリで処理し、さらに酸化アルミニウムで処理することによって前記式(6)で表される化合物としての精製された化合物21を得る(A3工程)。

15

20

25

アルカリとしては、例えば水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシドなどがあげられ、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシドが好ましく、さらに水酸化カリウム、ナトリウムメトキシドが好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えばメタノール、エタノールなどの低級アルコールがあげられ、低級アルコールが好ましく、さらにメタノール、エタノールが好ましく、特にメタノールが好ましい。ここで用いられるアルカリは、化合物20に対して通常0.01当量から0.3当量であり、0.1当量から0.3当量が好ましく、さらに0.2当量から0.3当量が好ましい。反応時間は、通常10分から50℃であり、10℃から40℃が好ましい。反応時間は、通常10分から120分であり、20分から60分が好ましく、さらに20分から40分が好ましい。

上記の操作により化合物 2 1 を得ることができる。ここで、得られた化合物 2 1 を吸着剤で処理してもよく、吸着剤で処理するのが好ましい。化合物 2 1 を吸着剤で処理することにより、前記化合物 2 0 を閉環する反応における副生成物である式(2 3)

で表される化合物、および式(24)

10

15

で表される化合物を除去することができ、精製された化合物 2 1 を得ることがで 20 きる。

用いられる吸着剤としては、酸化アルミニウムが好ましい。用いられる溶媒は、 反応に不活性であればよく、例えばn-ヘキサン、n-ヘブタンなどがあげられ、

÷

n-ヘプタンが好ましい。ここで用いられる吸着剤は、化合物20に対して通常0.5倍量から2倍量であり、0.8倍量から1.5倍量が好ましく、さらに0.8倍量から1.2倍量が好ましい。反応温度は、通常0℃から50℃であり、20℃から30℃が好ましい。反応時間は、通常10分から60分であり、20分から40分が好ましく、さらに25分から35分が好ましい。

次に、前記式(6)で表される化合物としての化合物21を脱保護して前記式 (1) で表される化合物としての化合物22を得る(A4工程)。ここで用いら れる脱保護剤としては、例えばn-ブチルリチウム、水素化ジイソブチルアルミ ニウム、水素化リチウムアルミニウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、カ リウムターシャリープトキシドなどがあげられ、水素化ジイソプチルアルミニウ 10 A、水素化リチウムアルミニウム、水酸化カリウム、カリウムターシャリーブト キシドが好ましく、さらに水素化リチウムアルミニウム、水酸化カリウムが好ま しい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えばテトラヒドロフラ ン、ジエチルエーテル、メチルー t ーブチルエーテルなどのエーテル類、および、 1-プロパノールなどのアルコール類、n-ヘプタンなどの飽和炭化水素類など 15 があげられ、テトラヒドロフラン、メチルー t - ブチルエーテル、1 - プロパノ ール、nーヘプタンが好ましく、さらにメチルーtーブチルエーテル、1ープロ パノールが好ましい。溶媒としてアルコール類を用いる場合には、無水アルコー ルが好ましい。ここで用いられる脱保護剤は、化合物21に対して通常1当量か ら2当量であり、1当量から1.5当量が好ましく、さらに1.1当量から1. 20 2 当量が好ましい。脱保護剤として水酸化カリウム、水酸化ナトリウムを用いる 場合には、化合物21に対して1当量から10当量が好ましく、さらに5当量か ら7当量が好ましい。反応温度は、溶媒がエーテル類である場合には、通常0℃ から60℃であり、30℃から55℃が好ましく、さらに45℃から55℃が好 ましい。溶媒がアルコール類である場合には、反応温度は溶媒の沸点付近が好ま 25 しく、さらに還流条件で反応を行うのが好ましい。反応時間は、通常30分から 5時間であり、1時間から3時間が好ましく、さらに2時間から3時間が好まし 41

ここで、脱保護剤として水酸化カリウム、水酸化ナトリウムを用いる場合には、

溶媒としては無水アルコールが好ましく、さらに無水1-プロバノールが好ましい。 脱保護剤として水酸化カリウム、水酸化ナトリウムを用いる場合には、溶媒として無水アルコール類を用い、還流条件で反応を行うのが特に好ましい。 また、脱保護剤としてカリウムターシャリープトキシドを用いる場合には、溶媒として n-ヘプタンを用い、還流条件で反応を行うのが好ましい。上記の操作により化合物 2 2 を得ることができるが、所望により、以下の操作によって精製することができ、精製するのが好ましい。

前記式(1)で表される化合物としての化合物22を分子蒸留により精製する(A5工程)。分子蒸留は公知の方法により行うことができる。

10 上記の製造方法において用いられる式(4)で表される化合物としての化合物 19は、本発明のD法によって製造されたものであるのが好ましい。

上記の製造方法において用いられる式(9)で表される化合物としての化合物 3 8 は、本発明の B 法によって製造されたものであるのが好ましい。

上記の製造方法において用いられる式(2)で表される化合物としての化合物 17は、本発明のB法またはC法によって製造されたものであるのが好ましい。

B法

(式中、A1、A2は保護基を示す。)

20

15

B法は、式(7)で表される化合物としての化合物25を原料として、式(9)で表される化合物としての化合物27、および、前記式(2)で表される化合物としての化合物28を製造する方法である。

まず、式 (7) で表される化合物としての化合物 2 5 を還元し、式 (8) で表 25 される化合物としての化合物 2 6 を得る (B1工程)。ここで用いられる還元方

法としては、例えばハイドロサルファイトナトリウムを用いる方法、水素による接触還元による方法などがあげられ、ハイドロサルファイトナトリウムを用いる方法が好ましい。還元方法としてハイドロサルファイトナトリウムを用いる方法を用いる場合、用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えばローヘキサン、シクロヘキサン、トルエン、酢酸エチルと水との混合溶媒などがあげられ、シクロヘキサン、酢酸エチルと水との混合溶媒が好ましい。ここで、相間移動触媒を用いてもよく、相間移動触媒を用いるのが好ましい。右間移動触媒としてはペンジルトリエチルアンモニウムクロリドが好ましい。ここで用いられる還元剤は、化合物25に対して通常1当量から3当量であり、1当量から2.5当量が好ましく、さらに1.2当量から2当量が好ましい。反応温度は、通常0℃から50℃であり、10℃から50℃が好ましく、さらに20℃から40℃が好ましい。反応時間は、通常0.5時間から3時間であり、0.5時間から3時間が好ましい。

10

15

20

25

次に、式(8)で表される化合物としての化合物26を酸触媒存在下、アシル化試薬で処理することにより水酸基を保護し、式(9)で表される化合物としての化合物27を得る(B2工程)。ここで用いられるアシル化試薬としては、例えば塩化アセチル、無水酢酸などがあげられ、無水酢酸が好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えばnーヘキサン、シクロヘキサン、トルエンなどがあげられ、nーヘキサン、シクロヘキサンが好ましい。アシル化試薬で処理する方法としては、例えば濃硫酸触媒を用いる方法、4ージメチルアミノビリジンで反応させた後に濃硫酸触媒を用いる方法などがあげられ、特に4ージメチルアミノビリジンで反応させた後に濃硫酸触媒を用いる方法が好ましい。ここで用いられるアシル化試薬は、化合物26に対して通常2当量から5当量であり、2.5当量から3当量が好ましい。反応温度は、通常0℃から80℃であり、20℃から60℃が好ましく、さらに45℃から55℃が好ましい。反応時間は、通常0.5時間から6時間であり、2.5時間から4時間が好ましい。

ここで、B1工程とB2工程において同一の溶媒を用いるのが、作業量低減お よびコスト低減の点で好ましい。B1工程とB2工程で同一の溶媒を用いる場合 の溶媒としては、例えばシクロヘキサンなどがあげられ、シクロヘキサンが好ま 1,63.

次に、式(9)で表される化合物としての化合物 2 7 を脱保護し、前記式(2)で表される化合物としての化合物 2 8 を得る(B 3 工程)。ここで用いられる脱保護剤としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどがあげられ、水酸化ナトリウムが好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えばメタノール、メタノールと水との混合溶媒などがあげられ、メタノールと水との混合溶媒が好ましい。ここで、メタノールと水との混合胎は、1:1 から3:2が好ましい。ここで用いられる脱保護剤は、化合物 2 7 に対して通常1 当量から1.5 当量であり、1.05 当量から1.2 当量が好ましい。反応温度は、通常10℃から40℃であり、20℃から40℃が好ましい。反応時間は、通常0.5時間から3時間であり、1時間から2時間が好ましい。

C法

10

20

25

15 (式中、A,は保護基を示す。)

C法は、式 (10) で表される化合物としての化合物 29 を原料として、前記式 (2) で表される化合物としての化合物 31 を製造する方法である。本製法は特開平 6-20684 2号公報などに記載されており、該公報記載の方法またはそれに準じた方法で製造することができる。

まず、式 (10) で表される化合物としての化合物 29 を酸触媒下、アシル化 試薬で処理することにより水酸基を保護し、式 (11) で表される化合物として の化合物 30 を得る(C1 工程)。ここで用いられるアシル化試薬としては、例 えば、塩化アセチル、無水酢酸などがあげられ、無水酢酸が好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えば、n-ヘキサン、トルエン、アセ

トニトリルなどがあげられ、アセトニトリルが好ましい。触媒としては、例えば 濃硫酸などがあげられ、濃硫酸が好ましい。ここで用いられるアシル化試薬は、 化合物 2 9 に対して通常 1 当量から 1 0 当量であり、1 当量から 5 当量が好まし く、さらに 1 当量から 1 . 5 当量が好ましい。反応温度は、通常 1 0 $\mathbb C$ から 1 0 $\mathbb C$ であり、1 0 $\mathbb C$ から 1 0 $\mathbb C$ が好ましい。反応時間は、通常 1 3 時間から 1 8 時間であり、1 5 時間から 1 2 時間が好ましい。

次に、式(11)で表される化合物としての化合物30を脱メチル化し、前記式(2)で表される化合物としての化合物31を得る(C2工程)。 ここで用いられる脱保護法としては、例えば、アセトニトリル中、塩化トリメチルシリルとヨウ化ナトリウムとの共存下で環流する方法などがあげられる。

D法

10

20

メタンスルホニル化 または パラトルエンスルホニル化 D3工程 化合物35 化合物36 化合物37

(式中、 X_1 、 X_2 はハロゲン原子を示す。 R_a はメタンスルホニル基またはp-15 トルエンスルホニル基を示す。)

D法は、前記式(12)で表される化合物としての化合物32を原料として、前記式(4)で表される化合物としての化合物37を製造する方法である。

まず、前記式(12)で表される化合物としての化合物32をマグネシウムで 処理し、前記式(13)で表される化合物としての化合物33を得る(D1工程)。ここで用いられるマグネシウムとしては、例えば、マグネシウム粉末、テープ状マグネシウム、削り状マグネシウムなどがあげられ、マグネシウム粉末が

10

15

20

25

好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどがあげられ、テトラヒドロフランが好ましい。 ここで用いられるマグネシウムは、化合物 32に対して通常 1 当量から 1.5 当量であり、1 当量から 1.1 当量が好ましい。反応温度は、通常 20 ℃から 40 ℃であり、30 ℃から 35 ℃が好ましい。反応時間は、通常 1 時間から 3 時間であり、1 時間から 2 時間が好ましい。

次に、前記式(13)で表される化合物としての化合物33を蟻酸エステルな どで処理し、前記式 (14) で表される化合物としての化合物 34を得る (D2 工程)。ここで用いられる蟻酸エステルとしては、例えば、蟻酸メチル、蟻酸エ チルなどがあげられ、蟻酸エチルが好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性 であればよく、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどがあげられ、 テトラヒドロフランが好ましい。ここで用いられる蟻酸エステルは、化合物33 に対して通常 0. 4 当量から 0. 5 当量であり、 0. 4 5 当量から 0. 5 当量が 好ましい。反応温度は、通常20℃から40℃であり、25℃から35℃が好ま しい。反応時間は、通常1時間から3時間であり、1時間から2時間が好ましい。 次に、前記式(14)で表される化合物としての化合物34をスルホニル化試 薬で処理し、前記式(15)で表される化合物としての化合物35を得る(D3 工程)。ここで用いられるスルホニル化試薬としては、例えば、塩化メタンスル ホニル、塩化p-トルエンスルホニルなどがあげられ、塩化メタンスルホニルが 好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えばジクロロメタ ン、ピリジンなどがあげられ、ピリジンが好ましい。ここで用いられるスルホニ ル化試薬は、化合物34に対して通常1当量から2当量であり、1.1当量から 1. 5 当量が好ましい。反応温度は、通常0℃から30℃であり、10℃から3 0℃が好ましい。反応時間は、通常3時間から12時間であり、5時間から8時 間が好ましい。

次に、前記式(15)で表される化合物としての化合物35をハロゲン化剤で 処理し、前記式(16)で表される化合物としての化合物36を得る(D4工程)。ここで用いられるハロゲン化剤としては、例えば、塩化カリウム、塩化リ チウム、臭化リチウム、ヨウ化リチウムなどがあげられ、塩化カリウム、塩化リ

1. 2当量から3当量が好ましく、さらに1. 5当量から2当量か好ましい。反応に温度は、通常25 \mathbb{C} から80 \mathbb{C} であり、50 \mathbb{C} から60 \mathbb{C} が好ましい。反応時間は、通常2時間から10時間であり、3時間から5時間が好ましい。

次に、前記式(16)で表される化合物としての化合物36をマグネシウムで処理し、前記式(4)で表される化合物としての化合物37を得る(D5工程)。ここで用いられるマグネシウムとしては、例えば、マグネシウム粉末、テープ状マグネシウム、削り状マグネシウムなどがあげられ、マグネシウム粉末が好ましい。また、反応前にマグネシウムを活性化させるために、マグネシウムの活性化剤を予めマグネシウムと反応させるか、化合物36と混合して反応させることもできる。マグネシウムの活性化剤としては、ヨウ素、ジブロモエタンなどがあげられ、ジブロモエタンが好ましい。用いられる溶媒は、反応に不活性であればよく、例えばテトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどがあげられ、テトラヒドロフランが好ましい。ここで用いられるマグネシウムは、化合物36に対して通常1当量から2当量であり、1.2当量から1.5当量が好ましい。反応温度は、通常25℃から40℃であり、30℃から40℃が好ましい。反応時間は、通常

実施例

以下に実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこの実施例によりなんら制限されるものではない。

2時間から12時間であり、2時間から3時間が好ましい。

25

5

10

15

20

(実施例1) 5-アセトキシ-4, 6-ジターシャリーブチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒドの合成

水冷下、メタンスルホン酸165mLにヘキサメチレンテトラミン53g(378mmol)を加えた。そこに4-アセトキシー3、5-ジターシャリープチ

ルフェノール50g(189mmol)を加え、90℃で1時間反応した。この液を30~40℃に冷却し、水450mLを加え、100℃で3時間攪拌した。この液を40℃に冷却し、10%酢酸エチルーへキサン180mLで2回抽出した。有機層を飽和食塩水150mLで洗浄し、溶媒を減圧留去した。残渣を通気乾燥機(並行流)にて50℃で一夜乾燥し、標記化合物39.75gを得た。得られた標記化合物の半量をとり、イソプロパノール75mLに加熱溶解した。この液を15℃に冷却し、結晶の析出を確認した後、水50mLを滴下した。この液を15℃に冷却し、0.5時間攪拌した。得られた結晶を遠心分離し、イソプロパノール・水混合溶媒(イソプロパノール:水=1:1)50mLで洗浄し、通気乾燥機(並行流)にて50℃で5時間乾燥し、5−アセトキシー4、6ージターシャリープチルー2ーヒドロキシベンズアルデヒド16.1gを得た。

¹H NMR (270MHz, CDCl₃) δppm: 1. 33 (s, 9H), 1. 52 (s, 9H), 2. 35 (s, 3H), 6. 93 (s, 1H), 10. 61 (s, 1H), 12. 30 (s, 1H)

IR (cm^{-1}) : 1758, 1637, 1373, 1211, 1176, 7

(実施例2) n-ペンチルマグネシウムブロミドの合成

マグネシウム粉末102g (4.2mo1)をテトラヒドロフラン1Lに懸濁 し、窒素雰囲気下、臭化n-ペンチル500mL (4.0mo1)を内温 $55\sim60$ 60 でを保ちながら6 時間かけて滴下した。その後室温で2 時間攪拌することに より、n-ペンチルマグネシウムプロミド/テトラヒドロフラン溶液を調製した。

(実施例3) 6-ウンデカノールの合成

10

15

25 実施例2で合成したnーペンチルマグネシウムプロミド/テトラヒドロフラン 溶液に窒素雰囲気下、室温で蟻酸エチル162mL(2.0mol)を滴下し、 そのまま室温で1昼夜攪拌した。この反応液に注意深く水を加えた後、希塩酸で 中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネ シウムで乾燥後濃縮し、6-ウンデカノール340.8gを得た。

PCT/JP01/06296 WO 02/06263

¹H NMR (270MHz, CDC1₂) δppm: 0.89 (t, 6H), 1. 22-1. 50 (m. 17H), 3. 59 (br. 1H)

(実施例4) 6-メタンスルホニルオキシウンデカンの合成

6-ウンデカノール29.95g(0.17mol)をピリジン60mLに溶 5 **輝した後、氷冷下塩化メタンスルホニル29.98g(0.26mol)を滴下** し、そのまま一夜攪拌した。その後、0.5N塩酸水35mLを加え、酢酸エチ ル200mLで2回抽出した。有機層を100mLの水、飽和食塩水の順で洗浄 した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。硫酸マグネシウムをろ過後、溶媒を 10 留去することにより、6-メタンスルホニルオキシウンデカン44.7gを得た。 ^{1}H NMR (270MHz, CDC1₂) δ ppm: 0. 90 (t, 6H), 1. 22-1. 48 (m. 12H), 1. 60-1, 77 (m. 4H), 2. 99 (s, 3H), 4.70 (m, 1H)

(実施例5) 6-クロロウンデカンの合成 15

25

6-メタンスルホニルオキシウンデカン30g(0.12mol)をN, N-ジメチルホルムアミド150mLに溶解し、氷水冷下無水塩化リチウム15. 3 g (0.36mol)を加えた。この液を50~55℃に加温し、そのまま3時 間攪拌した。その後15℃に冷却し、冷水300mLを加えた。反応液をヘキサ ン150mLで3回抽出し、有機層を水150mL、飽和食塩水150mLで順 20 次洗浄後無水硫酸マグネシウム6gで乾燥した。無水硫酸マグネシウムをろ過後、 溶媒を減圧留去し、6-クロロウンデカン22.2g(収率97.1%)を得た。 得られた6-クロロウンデカンを減圧蒸留し、本留(71 $\mathbb{C} \sim 72$ $\mathbb{C} / 9-1$ 0mmHg) として6-クロロウンデカン17.3g(収率75.7%)を得た。 ¹H. NMR (270MHz, CDCl₃) δ ppm: 0. 90 (t, 6H), 1. 20-1. 58 (m. 12H), 1. 62-1. 75 (m. 4H), 3. 8 9 (m. 1H)

(実施例6) 6-ウンデシルマグネシウムクロリドの合成

窒素気流下、マグネシウム17.1g(0.70mol)にテトラヒドロフラン114mLを加え、臭化エチレン1.1mLでマグネシウムを活性化させた。活性化を確認後6ークロロウンデカン111g(0.58mol)と臭化エチレン8.7mLのテトラヒドロフラン1030mL溶液を滴下し(1時間)、滴下。後、一夜攪拌を続け6ーウンデシルマグネシウムクロリド/テトラヒドロフラン溶液を得た。

(実施例 7) 4 - アセトキシ-3, 5 - ジターシャリーブチル-2 - (1 - ヒド ロキシ-2 - ペンチルヘプチル) フェノールの合成

22素雰囲気下、氷水冷下60%水素化ナトリウム13.0g(0.33mo
 1)にテトラヒドロフラン270mLを加え、そこに5-アセトキシ-4,6-ジターシャリープチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒド94.5g(0.32mol)のテトラヒドロフラン200mL溶液を滴下し、室温で1時間提拌した。その後、実施例6で調製したグリニヤール試薬を滴下し、室温で1時間反応した。
 15 氷水冷下飽和塩化アンモニウム水1000mLを加え、酢酸エチル1000mLで2回抽出した。有機層を飽和食塩水1000mLで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。硫酸マグネシウムをろ過後、濃縮し、濃縮物をヘキサン1000mLに加熱溶解した。その後、ゆっくりと0℃まで冷却晶析し、結晶を分離、乾燥し、4-アセトキシ-3、5-ジターシャリープチル-2-(1-ヒドロキ

¹H NMR (270MHz, CDCl₃) δppm: 0.74 (t, 3H), 0.91 (t, 3H), 0.95-1.63 (m, 16H), 1.29 (s, 9 H), 1.40 (s, 9H), 2.12 (m, 1H), 2.28 (s, 3H), 2.50 (d, 1H), 5.22 (dd, 1H), 6.77 (s, 1H), 7.

IR (cm^{-1}) : 3493, 1761, 1369, 1190, 908

シ-2-ペンチルヘプチル)フェノール85.6gを得た。

20

(実施例8) 5 - アセトキシ-4. 6 - ジターシャリーブチル-2, 2 - ジベンチル-2, 3 - ジヒドロベンゾフランの合成

¹H NMR (270MHz, CDCl₃) δppm: 0.88 (t, 6H), 1.22-1.39 (m, 12H), 1.30 (s, 9H), 1.37 (s, 9 15 H), 1.55-1.75 (m, 4H), 2.29 (s, 3H), 3.10 (d, 1H), 3.21 (d, 1H), 6.72 (s, 1H) IR (cm⁻¹):1760, 1567, 1365, 1214, 1172, 9

10

20

25

43

(実施例9) 4, 6 ージターシャリープチルー5-ヒドロキシー2, 2 ージペン

チルー2、3ージヒドロベンゾフランの合成

アルゴン雰囲気下、メチルー・プチルエーテル18Lに水素化リチウムアルミニウムを0.27kg加え0.5時間加熱遺流した。この液を30℃に冷却し、5-アセトキシー4.6-ジターシャリープチルー2,2-ジペンチルー2,3-ジヒドロペンゾフラン2.8kg/メチルー・プチルエーテル5L溶液を滴下後、アルゴン雰囲気下50℃で4.5時間攪拌した。この液を10℃に冷却し、飽和塩化アンモニウム水1.4Lをゆっくり滴下した。さらに10%塩酸水14Lを加え、ヘキサン14Lで抽出した。水層を廃棄し、飽和食塩水14Lで有機層を洗浄した後、減圧濃縮し、残渣をヘキサン12.5Lに溶解し、シリカゲル

2. 5 kgを加え、1時間機拌した。シリカゲルをろ過後、減圧濃縮し、4,6 ージターシャリーブチルー5ーヒドロキシー2,2ージペンチルー2,3ージヒドロベンゾフラン1.9 kg(純度99.4%)を得た。

¹H NMR (270MHz, CDCl₃) δppm: 0.88 (t, 6H), 1.22-1.39 (m, 12H), 1.40 (s, 9H), 1.49 (s, 9 H), 1.56-1.68 (m, 4H), 3.18 (s, 2H), 4.66 (s, 1H), 6.62 (s, 1H)

IR (cm⁻¹): 3650, 1614, 1573, 1411, 937, 75

10

15

5

(実施例10) 2, 6-ジターシャリープチルヒドロキノンの合成

水60mLにハイドロサルファイトナトリウム15.8g(90.8mmo1)、酢酸エチル50mL、2,6-ジターシャリープチルー1,4-ベンゾキノン10.0g(45.5mmo1)、ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド1.04g(4.57mmo1)を加え、25℃で1時間攪拌した。反応液を液液分離し、水層を廃棄した。有機層を10%食塩水20mLで洗浄し、溶媒を減圧留去し、2、6-ジターシャリープチルヒドロキノンを得た。

¹H NMR (270MHz, CDCl₃) δppm: 1. 41 (s, 18 H), 4, 46 (s, 1H), 4, 73 (s, 1H), 6, 68 (s, 2H)

20

25

<u>(実施例11) 1, 4-ジアセトキシー2, 6-ジターシャリープチルペンゼン</u> の合成

¹H NMR (270MHz, CDCl₃) δppm: 1. 33 (s, 18 H), 2. 28 (s, 3H), 2. 34 (s, 3H), 7. 03 (s, 2H)

(実施例12) 4-アセトキシ-3, 5-ジターシャリーブチルフェノールの合成

5

10

実施例11で得た1,4ージアセトキシー2,6ージターシャリープチルベンゼンをメタノール60mLに溶解した後、20℃に冷却し、水酸化カリウム3.30g(50.1mmo1)を加え、1.5時間攪拌した。この液を10~15℃に冷却し、水30mL、6N塩酸12.5mLを徐々に加えた。この液を5℃に冷却し、0.5時間攪拌した。結晶を速心分離し、メタノール・水混合溶媒(メタノール:水=1:1)10mLで洗浄し、通気乾燥機(並行流)にて50℃で一夜乾燥し、4ーアセトキシー3,5ージターシャリープチルフェノール10.97g(収率:実施例10の2,6ージターシャリープチルー1,4ーベンゾキノンから91.4%)を得た。

15 ¹H NMR (270MHz, CDCl₃) δppm: 1. 31 (s, 18
 H), 2. 33 (s, 3H), 4. 88 (s, 1H). 6. 76 (s. 2H)

(実施例13) 4-アセトキシ-3, 5-ジターシャリープチルアニソールの合成

20 2,6-ジターシャリーブチルー4ーメトキシフェノール1.50kg(6.35mol) および無水酢酸658mL(6.98mol)をアセトニトリル1.2 Lに溶かした溶液に、濃硫酸3mLを加え、室温で一昼夜攪拌した。この液に大過剰の水を加え、生成した固体を濾過し、乾燥させた。得られた4-アセトキシ-3,5-ジターシャリープチルアニソールを精製することなく次の反応に用いた。

(実施例14) 4-アセトキシ-3, 5-ジターシャリーブチルフェノールの合成

実施例13で得た4-アセトキシ-3,5-ジターシャリーブチルアニソール

(実施例15) 2, 6-ジターシャリープチルヒドロキノンの合成

5

10

15

20

25

水1. 2 Lにハイドロサルファイトナトリウム 2 2 3. 2 g (1. 0 9 m o 1)、シクロヘキサン1. 0 L、2, 6-ジターシャリープチルー1, 4-ベン ゾキノン 2 0 0. 0 g (9 0 8 m m o 1)、ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド 2 0. 7 g (9 0. 9 m m o 1)を加え、40で1時間提拌した。反応 液を液液分離し、水層を廃棄した。有機層を水 400 m L で洗浄し、2, 6-ジターシャリープチルヒドロキノン/シクロヘキサン溶液を得た。

<u>(実施例16)1,4-ジアセトキシー2,6-ジターシャリーブチルベンゼン</u> の合成

実施例15で得た2, 6 ージターシャリープチルヒドロキノン/シクロヘキサン溶液に、4 ージメチルアミノピリジン83. 3 mg (0. 6 8 mm o 1) を加え、5 0 \mathbb{C} にて無水酢酸 2 7 8. 4 g (2. 7 3 m o 1) をゆっくり滴下し、1 時間攪拌した。この反応液に硫酸 1 7. 8 g (1 8 1 mm o 1) をゆっくりと滴下し、5 0 \mathbb{C} で1時間攪拌した。この液を3 0 \mathbb{C} に冷却し、水6 0 0 m L を加え、液液分離し、水層を廃棄した。有機層を7. 5 %炭酸水素ナトリウム水 8 0 0 m L 、水 8 0 0 m L で順次洗浄し、1, 4 ージアセトキシー 2, 6 ージターシャリープチルベンゼン/シクロヘキサン溶液を得た。

(実施例17) 5-アセトキシー4, 6-ジターシャリーブチルー2-ヒドロキシベンズアルデヒドの合成

水冷下、メタンスルホン酸1396g(14.5mol)にヘキサメチレンテ トラミン254.6g(1.82mol)をゆっくりと加えた。そこに、実施例 16で得た1.4-ジアセトキシー2.6-ジターシャリーブチルベンゼン/シ クロヘキサン溶液を加え、しばらく攪拌した後、溶媒を減圧留去した。この反応 液を80℃で4時間攪拌した後、25℃に冷却し、水2.5Lを加え、90~1 00℃以上で6時間攪拌した。この液を30~40℃に冷却し、10%酢酸工チ ルーヘキサン1.01.で2回抽出した。有機層を水800mLで洗浄し、溶媒を 滅圧留去した。残渣にイソプロパノール800mLを加え、加熱溶解した後、1 10 0℃に冷却した。この液に、種晶(0.1g)を添加した後、結晶の析出を確認 し、続いて水560mLをゆっくりと滴下した。この液を0-5℃に冷却し、1. 5時間攪拌後、減圧下にてる過し、結晶をイソプロパノールー水混合溶媒(イソ プロパノール:x=1:1) 560mLで洗浄した。得られた結晶を減圧下(ロ -9リーエバポレータ) にて50℃で2.5時間乾燥し、5-アセトキシー4. 15 6-ジターシャリープチルー2-ヒドロキシベンズアルデヒド117.8g(収 窓・実施例15の2.6-ジターシャリープチルー1.4-ベンゾキノンから4 4.4%) を得た。

¹H NMR (270MHz, CDCl₃) δppm: 1. 33 (s, 9H), 1. 52 (s, 9H), 2. 35 (s, 3H), 6. 93 (s, 1H), 10. 61 (s. 1H), 12. 30 (s. 1H)

IR (cm^{-1}) : 1758, 1637, 1373, 1211, 1176, 779

m. p. : 79.0℃

25

20

(実施例18) 5-アセトキシー4.6-ジターシャリーブチルー2,2-ジペンチルー2,3-ジヒドロベンゾフランの合成

ヘプタン 3 5 0 mLに、4 - アセトキシ-3, 5 - ジターシャリーブチル-2 - (1-ヒドロキシ-2-ペンチルヘプチル) フェノール7 0. 0 g (1 5 6 m

mo1)を加え10℃以下に冷却した。三ふっ化ほう素ジエチルエーテル錯体4
4.3g(312mmo1)を10℃以下で滴下し、30℃に加温した後、5.5時間攪拌した。この液を10℃以下に冷却した後、7.5%炭酸水素ナトリウム水350mLを加え攪拌した。液液分雕し、有機層を水280mLで洗浄後、28%ナトリウムメチラート7.8g(40.4mmo1)、メタノール28mLを加え、室温で0.5時間攪拌した。反応液に水280mLを加え攪拌した後、水層を廃棄し、有機層を水280mLで洗浄した。有機層に無水硫酸マグネシウム28.0g、活性アルミナ70.0gを順次加え、室温で0.5時間攪拌した。反応液をろ過し、ろ液を減圧濃縮した後、1ープロパノール70mLを加え、再び減圧濃縮した。残渣に1ープロパノール70mLを加え、5ーアセトキシー4.6ージターシャリーブチルー2,2ージベンチルー2,3ージヒドロベンゾフラン/1ープロパノール溶液を得た。

<u>(実施例19) 4, 6-ジターシャリーブチル-5-ヒドロキシ-2, 2-ジペ</u> 15 ンチル-2, 3-ジヒドロベンゾフランの合成

10

窒素雰囲気下、水酸化カリウム49.0g(873mmol)に1-プロパノ ール210mLを加えた。反応容器内を減圧にした後、窒素によりブローする操 作を3回行い、窒素置換をした。この液を100-120℃に加熱し、水酸化力 リウムの溶解を確認した後、実施例18で得た5-アセトキシー4.6-ジター シャリープチルー2、2ージペンチルー2、3ージヒドロベンゾフラン/1ープ 20 ロパノール溶液を100-120℃にて滴下した。窒素雰囲気下、100℃以上 で2時間攪拌した後、この液を30℃に冷却し、25%クエン酸水120mLを ゆっくり滴下した。さらに、ヘプタン280mLを加え攪拌した後、液液分離を 行い、有機層を水280mL、7.5%炭酸水素ナトリウム水280mL、1 25 0%食塩水280mLで順次洗浄した。この有機層に無水硫酸マグネシウム28. 0gを加え乾燥後、減圧下にてろ渦を行った。このろ液を減圧濃縮し、4、6− ジターシャリープチル-5-ヒドロキシ-2,2-ジペンチル-2,3-ジヒド ロベンゾフラン56.5g(純度99.4%、収率:実施例18の4-アセトキ シー3,5-ジターシャリーブチルー2-(1-ヒドロキシー2-ペンチルヘプ

チル)フェノールから93.2%)を得た。

¹H NMR (270MHz, CDCl₃) δppm: 0.88 (t, 6H), 1.22-1.39 (m, 12H), 1.40 (s, 9H), 1.49 (s, 9 H), 1.56-1.68 (m, 4H), 3.18 (s, 2H), 4.66 (s, 1H), 6.62 (s.1H)

IR (cm^{-1}) : 3650, 1614, 1573, 1411, 937, 75

(実施例20) 4, 6 - ジターシャリーブチル-5-ヒドロキシ-2, 2 - ジペ 10 ンチル-2, 3 - ジヒドロベンゾフランの合成

ヘプタン22mLに、5-アセトキシー4.6-ジターシャリープチルー2,2-ジペンチルー2,3-ジヒドロペンゾフランおよびカリウムターシャリープトキシド1.68g(15.0mmo1)を加え、反応容器内を減圧にした後、アルゴンでプローする操作により、反応容器内をアルゴン置換した。この液を120℃の油浴にて加熱し、アルゴン雰囲気下で2時間還流した後、この液を室温まで冷却し、10%塩酸30mLを滴下した。さらに、15分間激しく攪拌した後、静置し、この有機層についてHPLC分析を行い、保持時間により4,6-ジターシャリープチルー5-ヒドロキシー2,2-ジペンチルー2,3-ジヒドロベンゾフランの牛成を確認した(純度99.36%)。

20

25

15

産業上の利用の可能性

本発明の製造方法は、(i) 最終生成物の精製品を得るのに必要な各反応工程での精製を、カラムクロマトグラフィーを使用することなく再結晶および吸着剤を用いた方法のみで行うことが可能であること、(ii) 従来の製造方法と比較して工程数の減少が可能であること、などの優れた効果を有し、工業的製造方法として有用である。

請求の節用

1. 式(1)

5 で表される化合物を製造する方法であって、式(2)

(式中、A,は保護基を示す)で表される化合物をホルミル化して式(3)

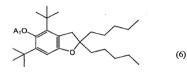
(式中、A,は保護基を示す)

10 で表される化合物を得る第1のステップと、式(3)で表される化合物を水素化 金属と反応させた後、式(4)

(式中、X₁はハロゲン原子を示す) で表される化合物と反応させて式(5)

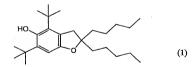
(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物を得る第3のステップと、式(5)で表される化合物を閉環して式(6)



(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を得る第5のステップと、式(6)で表される化合物を脱保護して、式(1)



10 で表される化合物を得る第7のステップとを行うことを特徴とする製造方法。2.式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、式(2)

(式中、A」は保護基を示す)

で表される化合物をホルミル化して式(3)

_

10

(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を得る第1のステップと、式(3)で表される化合物を低級アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式(3)で表される化合物を得る第2のステップと、式(3)で表される化合物を水素化金属と反応させた後、式(4)

(式中、X,はハロゲン原子を示す)

で表される化合物と反応させて式(5)

(式中、A」は保護基を示す)

5

10

で表される化合物を得る第3のステップと、式(5)で表される化合物を、炭化水素中または低級アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式(5)で表される化合物を得る第4のステップと、式(5)で表される化合物を閉環して式(6)

(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物を得る第5のステップと、式(6)で表される化合物を低級アルコール中アルカリで処理した後、酸化アルミニウムで処理することにより、精製された式(6)で表される化合物を得る第6のステップと、式(6)で表される化合物を脱保護して、式(1)

で表される化合物を得る第7のステップとを行うことを特徴とする製造方法。

- 3. 第7のステップの後に、さらに式(1)で表される化合物を分子蒸留を用 15 いて精製する第8のステップを行うことを特徴とする請求項1または2に記載の 製造方法。
 - 4. ホルミル化を、酸触媒存在下、ヘキサメチレンテトラミンで処理した後、加水分解することにより行うことを特徴とする、請求項1または2に記載の製造方法。

20 5. 式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、第1のステップの前に、式(7)

で表される化合物を還元して式(8)

で表される化合物を得る第9のステップと、式(8)で表される化合物の水酸基 を保護して式(9)

(式中、A1, A2は保護基を示す)

(式中、 A_1 は保護基を示す) で表される化合物を得る第11のステップとを行うことを特徴とする、請求項1または2に記載の製造方法。

6. 式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、第1のステップの前に、式(10)

で表される化合物の水酸基を保護し、式(11)

10 (式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物を得る第12のステップと、式(11)で表される化合物を脱メチル化して式(2)

(式中、A. は保護基を示す)

で表される化合物を得る第13のステップとを行うことを特徴とする、請求項1 または2に記載の製造方法。

5 7. 式(12)

20

$$X_2$$
 (12)

(式中、X₂はハロゲン原子を示す)

で表される化合物を、ジエチルエーテルあるいはテトラヒドロフラン中、マグネシウムで処理することにより式(13)

$$10$$
 MgX_2 (13)

(式中、X,はハロゲン原子を示す)

で表される化合物を得、得られた化合物を蟻酸エステルで処理することにより式 (14)

15 で表される化合物を得る第15のステップと、得られた化合物を塩化メタンスル ホニルあるいは塩化p-トルエンスルホニルで処理することにより式(15)

(式中、 R_1 はメタンスルホニル基またはp-トルエンスルホニル基を示す。) で表される化合物を得、得られた化合物をハロゲン化剤で処理することによりハロゲン化して式(16)

(式中、X,はハロゲン原子を示す)

で表される化合物を得、得られた化合物をマグネシウムで処理することにより式 (4)

(式中、 X_{ι} はハロゲン原子を示す。) で表される化合物を製造する方法。

8. 式(2)

5

10 (式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を酸触媒存在下へキサメチレンテトラミンで処理した後、加水 分解することにより式(3)

(式中、A,は保護基を示す)

15 で表される化合物を製造する方法。

9. 式(9)

(式中、A1, A2は保護基を示す)

で表される化合物を酸触媒存在下へキサメチレンテトラミンで処理した後、加水 分解することにより式(3)

Ð

(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を製造する方法。

10. 得られた式(3)で表される化合物を、さらに低級アルコールと水との 混合溶媒中で再結晶する工程を含む請求項8または9記載の製造方法。

10 11.式(3)

(式中、A₁は保護基を示す)

で表される化合物を水素化金属と反応させた後、式(4)

15 (式中、X₁はハロゲン原子を示す)

で表される化合物と反応させて式(5)

(式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を得、得られた式(5)で表される化合物を、炭化水素中また は低級アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式 (5)で表される化合物を製造する方法。

12. 式(5)

(式中、A, は保護基を示す)

10 で表される化合物を閉環して式(6)

(式中、A, は保護基を示す)

で表される化合物を得、得られた式(6)で表される化合物を低級アルコール中 アルカリで処理した後、酸化アルミニウムで処理することにより、精製された式 15 (6)で表される化合物を製造する方法。

13. 式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、式(9)

5 (式中、A₁, A₂は保護基を示す)

で表される化合物を酸触媒存在下ヘキサメチレンテトラミンで処理した後、加水 分解して式(3)

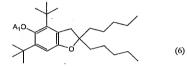
(式中、A1は保護基を示す)

10 で表される化合物を得る第14のステップと、式(3)で表される化合物を水素 化金属と反応させた後、式(4)

(式中、X₁はハロゲン原子を示す) で表される化合物と反応させて式(5)

(式中、A₁は保護基を示す)

で表される化合物を得る第3のステップと、式(5)で表される化合物を閉環して式(6)



(式中、A」は保護基を示す)

で表される化合物を得る第5のステップと、式(6)

(式中、A,は保護基を示す)

10 で表される化合物を脱保護して、式(1)

で表される化合物を得る第7のステップとを行うことを特徴とする製造方法。

14. 式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、式(9)

5 (式中、A₁, A₂は保護基を示す)

で表される化合物を酸触媒存在下へキサメチレンテトラミンで処理した後、加水 分解して式(3)

(式中、A」は保護基を示す)

10 で表される化合物を得る第14のステップと、式(3)で表される化合物を低級 アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式(3)で 表される化合物を得る第2のステップと、式(3)で表される化合物を水素化金 属と反応させた後、式(4)

15

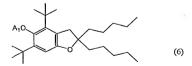
(式中、X₁はハロゲン原子を示す) で表される化合物と反応させて式(5)

(式中、A」は保護基を示す)

5 で表される化合物を得る第3のステップと、式(5)で表される化合物を、炭化水素中または低級アルコールと水との混合溶媒中で再結晶することにより、精製された式(5)で表される化合物を得る第4のステップと、式(5)で表される化合物を開環して式(6)

10 (式中、A,は保護基を示す)

で表される化合物を得る第5のステップと、式(6)で表される化合物を低級アルコール中アルカリで処理した後、酸化アルミニウムで処理することにより、精 製された式(6)で表される化合物を得る第6のステップと、式(6)



15 (式中、A」は保護基を示す)
で表される化合物を脱保護して、式(1)

で表される化合物を得る第7のステップとを行うことを特徴とする製造方法。

15. 第7のステップの後に、さらに式(1)で表される化合物を分子蒸留を 用いて精製する第8のステップを行うことを特徴とする請求項13または14に 5 記載の製造方法。

16. 式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、第14のステップの前に、式(7)

10 で表される化合物を還元して式(8)

で表される化合物を得る第9のステップと、式(8)で表される化合物の水酸基を保護して式(9)

(式中、A, A, は保護基を示す)

で表される化合物を得る第10のステップとを行うことを特徴とする、請求項1 3または14に記載の製造方法。

5 17. 式(1)

で表される化合物を製造する方法であって、使用される式(4)で表される化合物が下記の方法で製造されたものであることを特徴とする、請求項1、2, 13 または14 のいずれか1項に記載の製造方法;

10 式(12)

$$X_2$$
 (12)

(式中、X₂はハロゲン原子を示す)で表される化合物を、ジエチルエーテルあるいはテトラヒドロフラン中、マグネシウムで処理することにより式(13)

$$MgX_2$$
 (13)

15 (式中、X₂はハロゲン原子を示す)で表される化合物を得、得られた化合物を 蟻酸エステルで処理することにより式(14)

で表される化合物を得、得られた化合物を塩化メタンスルホニルあるいは塩化 p ートルエンスルホニルで処理することにより式(15)

(式中、 R_1 はメタンスルホニル基またはp-トルエンスルホニル基を示す。) で表される化合物を得、得られた化合物をハロゲン化剤で処理することによりハロゲン化して式(16)

5

(式中、 X_1 はハロゲン原子を示す)で表される化合物を得、得られた化合物を マグネシウムで処理することにより式(4)

(式中、X₁はハロゲン原子を示す。)で表される化合物を製造する。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/06296

A.	CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 C07D307/79, C07C67/29, C07	C69/16, C07C67/293, C07C	c69/18, C07F3/02			
Acco	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED							
Mini	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07D307/79, C07C67/29, C07C69/16, C07C67/293, C07C69/18, C07F3/02						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched							
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA (STN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)							
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
	gory*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
	A	WO 94/08930 A (Chugai Pharmaceu 28 April, 1994 (28.04.94), the whole document & JP 6-206842 A	ntical Co., Ltd.),	1-17			
	A	JP 7-188094 A (Sepracor, Inc.), 25 July, 1995 (25.07.95), the whole document & EP 650952 A		1-17			
Further documents are listed in the continuation of Box C.			See patent family annex.				
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "B" carlier document but published on or after the international filing date the comment which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another clustion or other document efferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed			"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular retwance; the chairmed invention eannot be considered not of particular retwance; the chairmed invention eannot be step when the document is taken alone at the particular retwance and invention eannot be considered to livolve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report				
		ugust, 2001 (20.08.01)	28 August, 2001 (28				
Nan		nailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer				
٦.			Telephone No				

発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int cl' C07D307/79, C07C67/29, C07C69/16, C07C67/293, C 07C69/18, C07F3/02

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

阻害するし即みたれる立跡

Int c1' C07D307/79, C07C67/29, C07C69/16, C07C67/293, C 07C69/18, C07F3/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)

し、 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	WO 94/08930 A (中外製薬株式会社)28.4月.1 994 (28.04.94) 文献全体 & JP 6-20684 2 A	1-17	
. А	JP 7-188094 A (セプラコア、インコーボレイテッド)25.7月.1995 (25.07.95) 文献全体 & EP 650952 A	1-17	
□ C欄の続き	の続きにも文献が列挙されている。		
* 引用文献	* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献		

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願目 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 28.08.01 20.08.01 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 P 8615 日本国特許庁 (ISA/JP) 内藤 伸一 郵便番号100-8915 東京都千代田区微が関三丁目 4番 3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3492